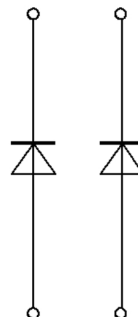


hochisolierendes Modul  
high insulated module



$V_{CES} = 6500V$   
 $I_{C\ nom} = 500A / I_{CRM} = 1000A$

**Typische Anwendungen**

- Mittelspannungsantriebe
- Traktionsumrichter

**Typical Applications**

- Medium Voltage Converters
- Traction Drives

**Mechanische Eigenschaften**

- AISiC Bodenplatte für erhöhte thermische Lastwechselfestigkeit
- Erweiterter Lagertemperaturbereich bis zu  $T_{stg} = -55^{\circ}C$
- Gehäuse mit CTI > 600
- Gehäuse mit erweiterten Isolationseigenschaften von 10,2kV AC 1min
- Große Luft- und Kriechstrecken

**Mechanical Features**

- AISiC Base Plate for increased Thermal Cycling Capability
- Extended Storage Temperature down to  $T_{stg} = -55^{\circ}C$
- Package with CTI > 600
- Package with enhanced Insulation of 10.2kV AC 1min
- High Creepage and Clearance Distances

**Module Label Code**

Barcode Code 128



DMX - Code



**Content of the Code**

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

prepared by: DTH	date of publication: 2014-06-16	
approved by: DTS	revision: 3.0	UL approved (E83335)

**Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter**

**Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values**

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = -50^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	6500 6500 5900	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		$I_F$	500	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	$t_P = 1 \text{ ms}$	$I_{FRM}$	1000	A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	210	$\text{kA}^2\text{s}$
Spitzenverlustleistung Maximum power dissipation	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$P_{RQM}$	2000	kW
Mindesteinschaltdauer Minimum turn-on time		$t_{on \text{ min}}$	10,0	$\mu\text{s}$

**Charakteristische Werte / Characteristic Values**

		min.	typ.	max.		
Durchlassspannung Forward voltage	$I_F = 500 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 500 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_F$	3,00 2,95	3,50 3,50	V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	$I_F = 500 \text{ A}, -di_F/dt = 2000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=125^{\circ}\text{C})$ $V_R = 3600 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I_{RM}$	730 800		A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	$I_F = 500 \text{ A}, -di_F/dt = 2000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=125^{\circ}\text{C})$ $V_R = 3600 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$Q_r$	570 1050		$\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	$I_F = 500 \text{ A}, -di_F/dt = 2000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=125^{\circ}\text{C})$ $V_R = 3600 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$E_{rec}$	930 2000		mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode		$R_{thJC}$		28,0	K/kW
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		$R_{thCH}$		16,0	K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj \text{ op}}$	-50	125	$^{\circ}\text{C}$

prepared by: DTH	date of publication: 2014-06-16
approved by: DTS	revision: 3.0



**Modul / Module**

Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V <sub>ISOL</sub>	10,2		kV
Teilentladungs-Aussetzspannung Partial discharge extinction voltage	RMS, f = 50 Hz, Q <sub>PD</sub> typ 10 pC (acc. to IEC 1287)	V <sub>ISOL</sub>	5,1		kV
Kollektor-Emitter-Gleichsperrspannung DC stability	T <sub>vj</sub> = 25°C, 100 fit	V <sub>CE D</sub>	3800		V
Material Modulgrundplatte Material of module baseplate			AISiC		
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		AlN		
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		56,0 56,0		mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		26,0 26,0		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI	> 600		
			min.	typ.	max.
Modulstreuintuktivität Stray inductance module		L <sub>sCE</sub>		25	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip	T <sub>c</sub> = 25°C, pro Schalter / per switch	R <sub>AA+CC'</sub>		0,37	mΩ
Lagertemperatur Storage temperature		T <sub>stg</sub>	-55		125 °C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage Mounting torque for modul mounting	Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	4,25	-	5,75 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse Terminal connection torque	Schraube M8 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M8 - Mounting according to valid application note	M	8,0	-	10 Nm
Gewicht Weight		G		1000	g

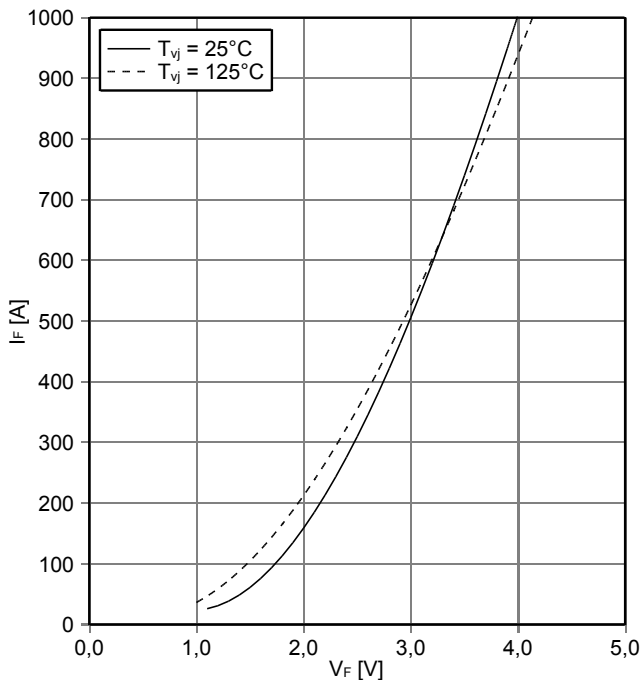
Dynamische Daten gelten in Verbindung mit FZ500R65KE3 Modul  
Dynamic Data valid in conjunction with FZ500R65KE3 module

prepared by: DTH	date of publication: 2014-06-16
approved by: DTS	revision: 3.0



**Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)**  
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)

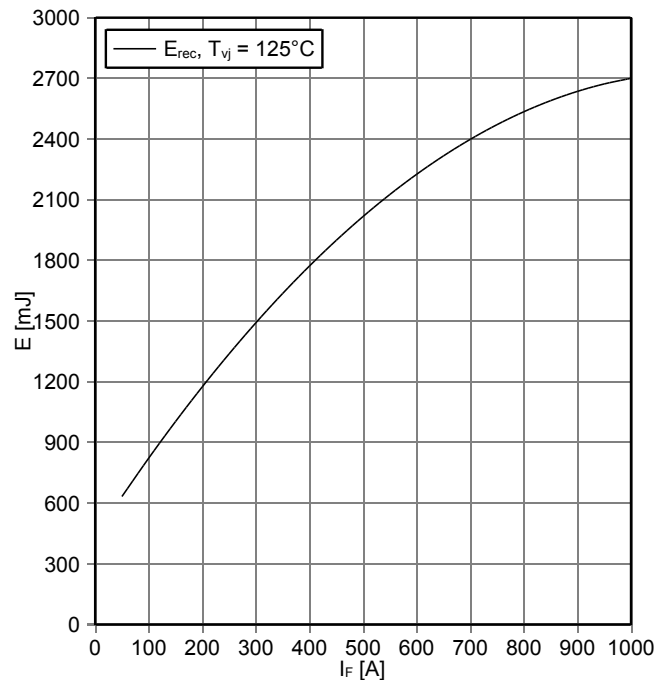
$I_F = f(V_F)$



**Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)**  
switching losses Diode, Inverter (typical)

$E_{rec} = f(I_F)$

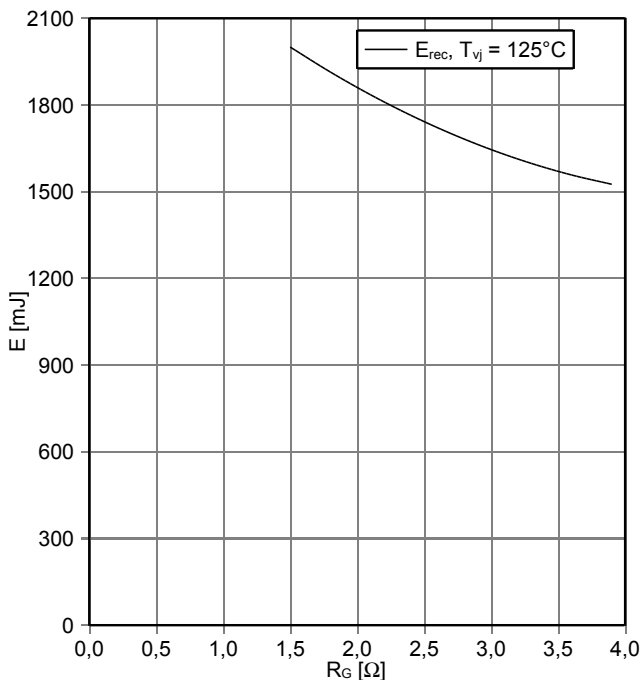
$R_{Gon} = \Omega, V_{CE} = 3600 V$



**Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)**  
switching losses Diode, Inverter (typical)

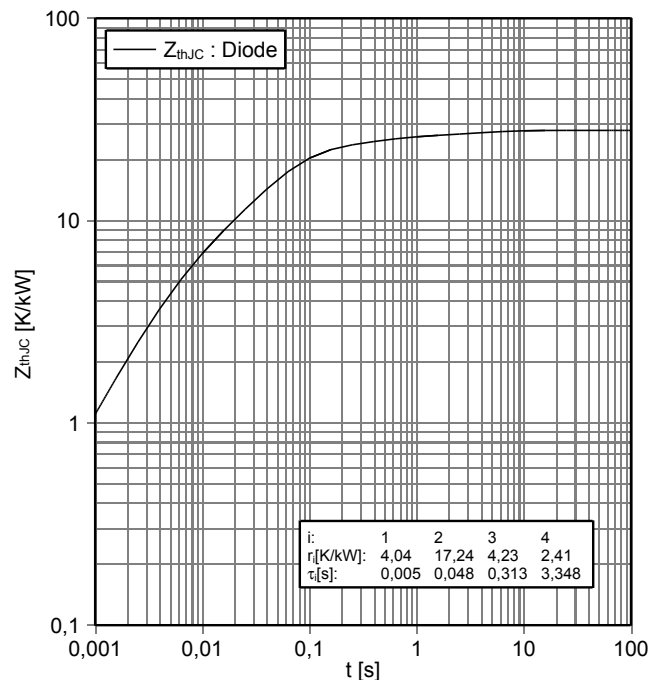
$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 500 A, V_{CE} = 3600 V$



**Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter**  
transient thermal impedance Diode, Inverter

$Z_{thJC} = f(t)$

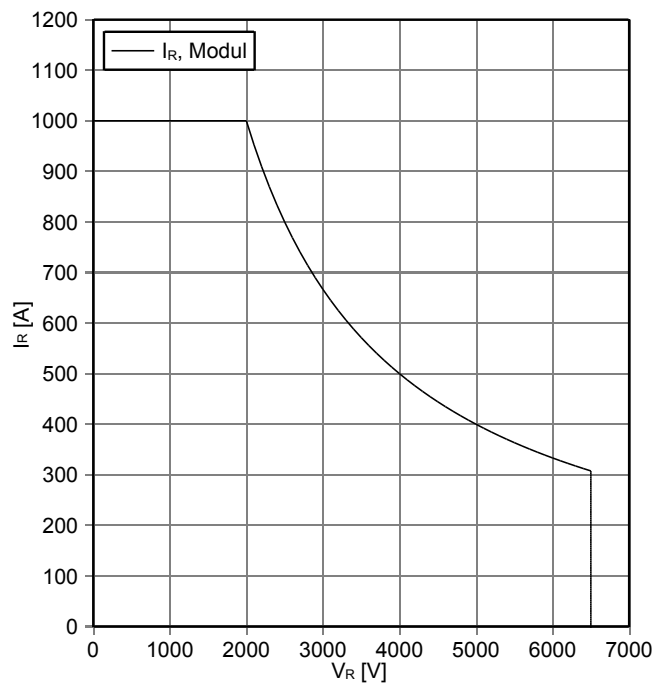


prepared by: DTH	date of publication: 2014-06-16
approved by: DTS	revision: 3.0



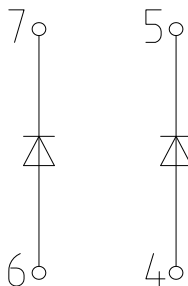
**Sicherer Arbeitsbereich Diode, Wechselrichter (SOA)**  
**safe operation area Diode, Inverter (SOA)**

$I_R = f(V_R)$   
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

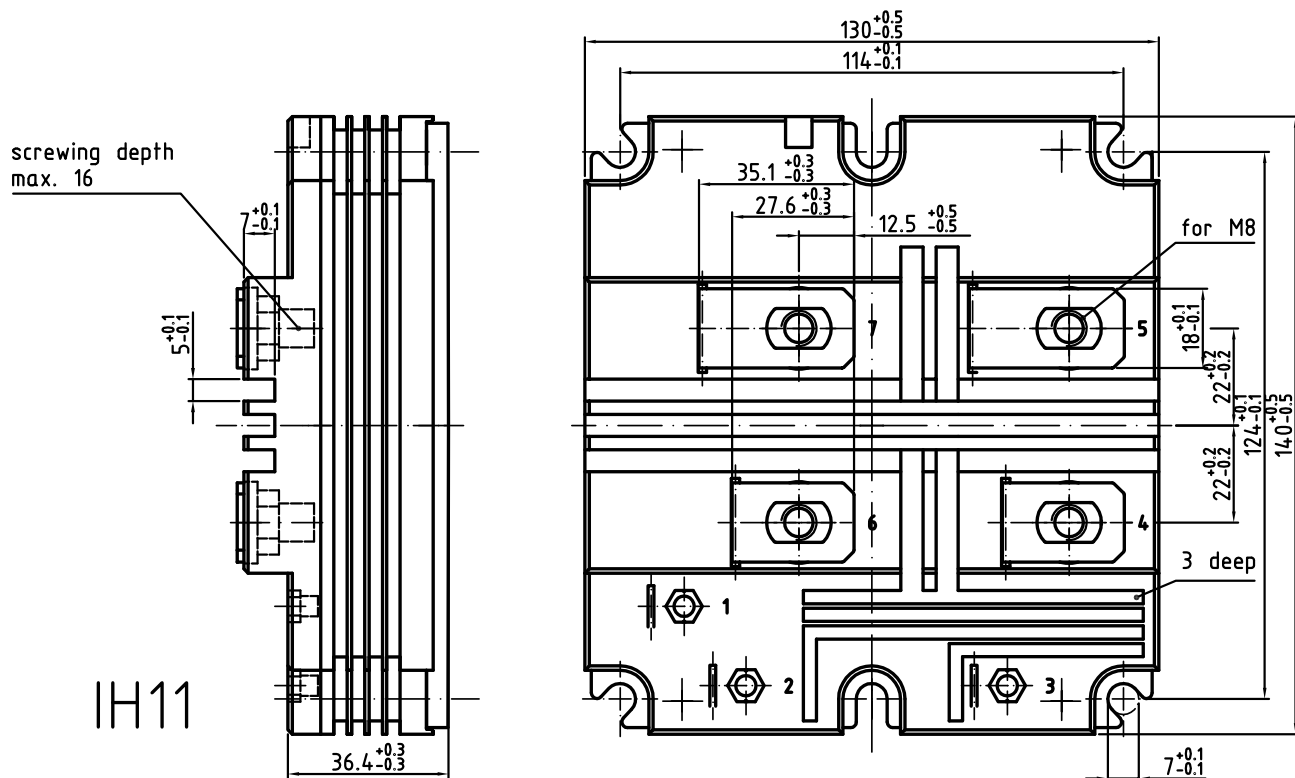
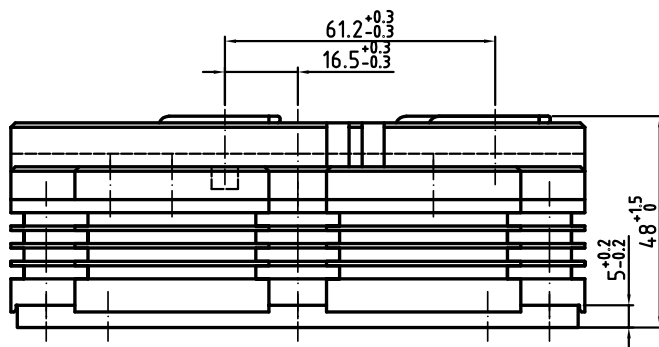


prepared by: DTH	date of publication: 2014-06-16
approved by: DTS	revision: 3.0

Schaltplan / circuit\_diagram\_headline



Gehäuseabmessungen / package outlines



IH11

prepared by: DTH	date of publication: 2014-06-16
approved by: DTS	revision: 3.0



**Nutzungsbedingungen**

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen. Die Angaben in den gültigen Anwendungs- und Montagehinweisen des Moduls sind zu beachten.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.infineon.com](http://www.infineon.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

**Terms & Conditions of usage**

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. The information in the valid application- and assembly notes of the module must be considered.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you ( see [www.infineon.com](http://www.infineon.com) ). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: DTH	date of publication: 2014-06-16
approved by: DTS	revision: 3.0

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9